

(TSRI) P15-113A 下線晶片資料

請注意：

- 1.此資料包含:下線晶片與不下線晶片。
- 2.下線晶片資料按 10%部分負擔、新進教師晶片、優良晶片、教育性晶片排列。
- 3.申請編號中，序號英文字母代表：A:10%部分負擔，E:教育性晶片，N:新進教師晶片，I:優良晶片。序號之尾端字母代表：a:使用 Cell-based Design Kit，m:使用 Multi-option-MEMS(TSRI MEMS 後製程)，M:整合晶片。
- 4.可否下線準則依序: 有無回覆委員建議(未回覆完整視同未回覆,不予下線)、審查評等結果(優先順序為 A>B>C，D:視面積使用情況下線，F:不予下線)、教授加總積點、是否為科技部計畫所需、可擺放的剩餘面積等。
- 5.若委員建議修改佈局，依規定不可比原佈局增加長寬邊的長度，違者則不予採用已修改之佈局檔案。

下線晶片資料(申請編號/專題名稱(課程名稱)/包裝形式/晶片面積)：

申請編號: P15-113A-A0003

專題名稱(中文): Ku-Band 低雜訊放大器設計

專題名稱(英文): The Design of Low Noise Amplifier for Ku-Band

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.000*1.000 mm²

申請編號: P15-113A-A0004

專題名稱(中文): X-Band 頻段低雜訊放大器設計

專題名稱(英文): The Design of Low Noise Amplifier for X-Band

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.000*1.000 mm²

申請編號: P15-113A-A0006

專題名稱(中文): 採用多段微帶線與電容的組合來實現寬頻 Ka-Band Two-Stage AB 類功率放大器

專題名稱(英文): The implementation of a broadband Ka-Band two-stage Class AB power amplifier using a combination of multi-section microstrip lines and capacitors

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 3.000*2.000 mm²

申請編號: P15-113A-A0009

專題名稱(中文): 適用於 Ka-band 低軌衛星發射機系統之單刀雙擲切換器

專題名稱(英文): A SPDT Switch for Ka-band Low-Earth-Orbit Satellite Transmitter System

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.000*2.000 mm²

申請編號: P15-113A-A0010

專題名稱(中文): 適用於 Ka-band 低軌衛星通訊系統之非對稱吸收式單刀雙擲切換器

專題名稱(英文): An Asymmetric Absorptive SPDT Switch for Ka-band Low-Earth-Orbit Satellite Communication Systems

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.000*2.000 mm²

申請編號: P15-113A-A0012

專題名稱(中文): 雙通道 P15 PHEMT 可調雷射二極管驅動器

專題名稱(英文): A Dual-channel P15 PHEMT tunable laser diode driver

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.000*2.000 mm²

申請編號: P15-113A-E0001

專題名稱(中文): 類比與數位訊號轉換器設計(null)

專題名稱(英文): 應用於低軌衛星通訊之 19GHz 砷化鎵低雜訊放大器(19 GHz GaAs Low Noise Amplifier for Low Earth Orbit Satellite Communication)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 2.000*1.000 mm²

申請編號: P15-113A-E0002

專題名稱(中文): 射頻積體電路設計(null)

專題名稱(英文): 應用於 Ku 頻帶使用電抗補償技術與濾波器作為級間匹配之寬頻 E 類功率放大器(Broadband Class E Power Amplifier with Reactance Compensation Technique and Interstage Matching Using Filters in Ku-band)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 2.000*1.000 mm²

申請編號: P15-113A-E0003

專題名稱(中文): 微波及毫米波頻率合成器(null)

專題名稱(英文): 應用於全 Ka 頻帶使用疊接 FET 之 J 類功率放大器(Design of a Full Ka-Band Stacked-FET Power Amplifier with Class J Configuration)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 2.000*1.000 mm²

申請編號: P15-113A-E0005

專題名稱(中文): 微波工程(一)(null)

專題名稱(英文): 使用負壓產生器之 28 GHz 功率放大器(28 GHz Power Amplifier Using Negative Voltage Generator)
包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA
晶片面積: 1.500*2.000 mm²

申請編號: P15-113A-E0006

專題名稱(中文): 微波電路設計與製造(null)

專題名稱(英文): 使用負壓產生器之 pHEMT 毫米波前端開關電路(Millimeter wave SPDT Switch Using Negative Voltage Generator)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.500*2.000 mm²

申請編號: P15-113A-E0007

專題名稱(中文): 學位論文研究(null)

專題名稱(英文): 具對數功率檢測功能之 28GHz 毫米波功率放大器(28GHz Millimeterwave Power Amplifier with logarithmic power detector)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.500*2.000 mm²

申請編號: P15-113A-E0008

專題名稱(中文): 微波元件(null)

專題名稱(英文): 應用於 5G 通訊對稱變壓器之研究(Study of symmetrical transformers for 5G communications)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 2.000*1.000 mm²

申請編號: P15-113A-E0009

專題名稱(中文): 類比與數位訊號轉換器設計(null)

專題名稱(英文): 用於低軌衛星 28GHz 之砷化鎵低雜訊放大器(GaAs Low Noise Amplifier used in low-Earth orbit Satellites)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.500*1.000 mm²

申請編號: P15-113A-E0011

專題名稱(中文): 微波主動電路專題(null)

專題名稱(英文): 假晶式高速電子遷移率電晶體之 A 類功率放大器以九個負載點之 X 參數模型設計(X-parameter modelling of pseudomorphic high-speed electron mobility transistor for class A power amplifier with nine load points)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.500*1.000 mm²

申請編號: P15-113A-E0012

專題名稱(中文): 微波主動電路專題(null)

專題名稱(英文): 使用九個負載之 X 參數模型來設計 Class AB 類假晶式高速電子遷移率電晶體功率放大器(Designing a Class AB pseudomorphic high electron mobility transistor (pHEMT) power amplifier using an X-parameter model with nine loads points.)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.500*1.000 mm²

申請編號: P15-113A-E0013

專題名稱(中文): 高等微波元件專題(null)

專題名稱(英文): 利用負載拉移建立 X 參數模型應用於假晶式高速電子遷移率電晶體功率放大器設計(Using load pull to establish an X-parameter model for the design of pseudomorphic high-electron-mobility transistor (pHEMT) power amplifiers)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.500*1.000 mm²

申請編號: P15-113A-E0014

專題名稱(中文): 微波工程(一)(null)

專題名稱(英文): 28 GHz 多爾蒂功率放大器(28 GHz Doherty Power Amplifier)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.500*2.000 mm²

申請編號: P15-113A-E0015

專題名稱(中文): 微波電路設計與製造(null)

專題名稱(英文): 二級 28GHz 功率放大器及毫米波對數功率檢測器之設計(Design of two-stage 28GHz power amplifier and millimeter wave logarithmic power detector)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 3.000*1.000 mm²

申請編號: P15-113A-E0016

專題名稱(中文): 微波元件(Microwave Devices)

專題名稱(英文): 應用於 5G 通訊 GaAs 低雜訊放大器的相鄰耦合傳輸線(Adjacent Coupled TL for GaAs LNA for 5G Applications)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.500*2.000 mm²

申請編號: P15-113A-E0017

專題名稱(中文): 微波元件(Microwave Devices)

專題名稱(英文): 應用於 5G 通訊 GaAs 低雜訊放大器的對角耦合傳輸線(Diagonal Coupled TL for GaAs LNA for 5G Applications)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.500*2.000 mm²

申請編號: P15-113A-E0018

專題名稱(中文): 微波電路(null)

專題名稱(英文): 使用電容共振技術的高功率單刀雙擲切換器(High Power Single-Pole-Double-Throw Switch Using Capacitance using Resonance Approach)

包裝形式: Package:N/A + DieSort:18EA

晶片面積: 1.000*1.000 mm²

=====